

习题课讲义

诸葛佳明

2022 年 4 月 23 日

1 标量、矢量与张量

标量 (0 阶张量):

$$\varphi$$

矢量 (1 阶张量):

$$\boldsymbol{E}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{H}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{M}$$

* 张量 (2 阶): 广义电容, 电极化张量

$$\overleftrightarrow{\chi}_e = \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} \end{pmatrix}$$

1.1 基矢的表示

$$\hat{e}_x = \hat{x} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$$

$$\hat{e}_r = \hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$$\hat{e}_\theta = \hat{\theta} = \frac{\vec{\theta}}{|\vec{\theta}|}$$

1.2 Nabla 算子, ∇

$$\nabla = \sum_i \hat{x}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

P314, 附录

1.2.1 直角坐标系

梯度

$$\nabla\Phi = grad\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\hat{z}$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = div\mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = rot\mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

1.2.2 柱坐标系

梯度

$$\nabla\Phi = grad\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\hat{z}$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = div\mathbf{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

1.2.3 球坐标系

梯度

$$\nabla\Phi = grad\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\Phi}{\partial\phi}\hat{\phi}$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = div\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\theta\sin\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial\phi}$$

1.2.4 * 一般正交曲线坐标系

Lame 系数

对任意一组正交曲线坐标系基矢 $\hat{u}_a (a = 1, 2, 3)$, 定义 Lame 系数:

$$d\mathbf{l} = \sum_{a=1}^3 (h_a du_a) \hat{u}_a$$

定义 $H = h_1 h_2 h_3$

梯度、散度、旋度由以下给出:

$$Grad(f) = \sum_{a=1}^3 \frac{\hat{u}_a}{h_a} \frac{\partial f}{\partial u_a} = \left(\frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1}, \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2}, \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \right)$$

$$Div(\mathbf{F}) = \frac{1}{H} \sum_{a=1}^3 \left(\frac{H}{h_a} F_a \right)$$

$$\text{Curl}(\mathbf{F}) = \frac{1}{H} \begin{vmatrix} h_1 \hat{u}_1 & h_2 \hat{u}_2 & h_3 \hat{u}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \end{vmatrix}$$

例如，对球坐标，有：

$$h_r = 1, h_\theta = r, h_\phi = r \sin \theta, H = r^2 \sin \theta$$

对柱坐标有：

$$h_r = 1, h_\phi = r, h_z = 1, H = r$$

2 高斯定理与环路定理

积分形式：

$$\begin{cases} \iint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_0 \\ \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \end{cases}$$

微分形式：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

D 与 E 关系：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E}$$

总电荷、自由电荷、极化电荷关系：

$$\rho = \rho_0 + \rho'$$

得到：

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0 \\ -\nabla \cdot \mathbf{P} = \rho' \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

利用数学上的 Gauss 定理，得到以下规律：

1. 将 ∇ 改为垂直于面的单位向量 \hat{n} ，由 1 指向 2
2. 将 ∇ 作用的场或源 \mathbf{F} 改为 $\mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_1$
3. 其余场改为 0，其余源由体密度改为面密度

由此得到:

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_0 \\ -\hat{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = \sigma' \\ \hat{n} \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

前两式常用于求自由电荷面密度和极化电荷面密度, 最后一式常用于给出边界条件 (电动力学)

(例 2.11 边界条件)

2.1 习题 2.14

2.14 半径为 a 、 b ($a < b$) 的同心导体球壳之间充满非均匀介质, 介电常量为 $\varepsilon = \varepsilon_0 / (1 + kr)$, 其中 k 为常数, r 为径向距离. 内球壳表面有电荷 Q , 外球壳接地. 计算

- (1) 系统的电容;
- (2) 介质内的极化电荷密度;
- (3) 球面上极化电荷面密度.

图 1: 习题 2.14

(1)

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 D &= Q (a < r < b) \\ \mathbf{D} &= \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} \\ \mathbf{E} &= \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon r^2} \hat{r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} (1 + kr) \hat{r} \\ V &= \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + k \ln \frac{b}{a} \right) \\ C &= \frac{Q}{U} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{P} &= (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{E} = -\frac{kQ}{4\pi r} \hat{r} \\ \rho' &= -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 P_r) = \frac{kQ}{4\pi r^2} \end{aligned}$$

(3)

取 $\hat{n} = \hat{r}$, 注意导体一侧 $\mathbf{P} = 0$

$$\sigma'_a = -\hat{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = -\hat{r} \cdot \mathbf{P}_2 = \frac{kQ}{4\pi a}$$

$$\sigma'_b = -\hat{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = \hat{r} \cdot \mathbf{P}_1 = -\frac{kQ}{4\pi b}$$

2.2 习题 2.19

2.19 如习题 2.19 图所示, 一导体球外充满两半无限电介质, 介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 , 介质界面为通过球心的无限平面. 设导体球半径为 a , 总电荷为 q , 求空间电场分布和导体球表面的自由面电荷分布.

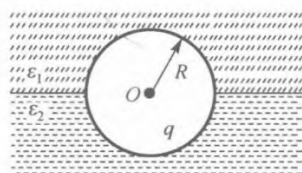


图 2: 习题 2.19

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)2\pi r^2 E = q$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)r^2} \hat{r}$$

$$\mathbf{D}_1 = \varepsilon_1 \mathbf{E}, \mathbf{D}_2 = \varepsilon_2 \mathbf{E}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0$$

取 $\hat{n} = \hat{r}$, 注意导体内 $\mathbf{D} = 0$

$$\sigma_1 = \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_{1,out} - \mathbf{D}_{1,in}) = \hat{n} \cdot \mathbf{D}_{1,out} = D_1$$

区域 2 类似

注意介质面垂直和平行于电场线的区别

2.3 习题 2.20

2.20 把平行板电容器的两极板接到电源上（接通 K），然后在电容器内左半区中放入介电常量为 ϵ 的电介质（习题 2.20 图）。

（1）问 A、B 两点的场强哪个大？各为没有介质时的多少倍？

（2）如果在充电后，先把电源断开（即断开 K），再在左半区中放入介质，电场强度如何变化？

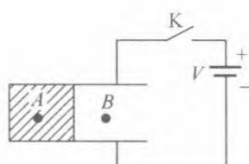


图 3: 习题 2.20

(1)

电源连接，V 不变，则 E 也不变

(2)

电源断开，Q 不变。加入介质后，A 区有极化电荷，为保证 A、B 区域 U 相同，B 板会有自由电荷去 A 板，直到平衡。可以定性知道 E 必减小（多了极化电荷）

$$Q_0 = C_0 E_0 d = C_1 E_1 d$$
$$E_1 = \frac{C_0}{C_1} E_0 = \frac{2\epsilon_0}{\epsilon_0 + \epsilon} E_0$$

3 电像法（导体）

1. 平面

2. 球面（内、外）

3. 无数个像电荷（等比数列求和）

3.1 习题 2.23

***2.23** 如习题2.23图(a)所示,一半径为 R 的导体球壳,球内部距离球心为 $d(d < R)$ 处有一点电荷 q ,求

- (1) 当球壳接地时球内的电场强度和电势;
- (2) 当球壳不接地且带电量为 Q 时球内的电场强度和电势.

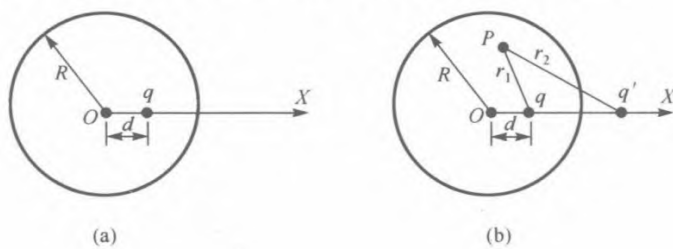


图 4: 习题 2.23

(1)

设像电荷与 O 点距离为 b

$$\begin{cases} bd = R^2 \\ \frac{q'}{b - R} = -\frac{q}{R - d} \end{cases}$$

$$\Rightarrow q' = -\frac{R}{d}q$$

(2)

不接地后,以无穷远为电势零点。(1)中 q' 已经保证了导体壳电势为零时的感应电荷分布。需要在球壳外表面均匀分布 $Q+q$ 电势。 Q 是另加的, q 相当于内部源电荷感应出的外表面电荷(电势不为0)。

$$U = U_1 + \frac{Q + q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

附加 (3)

考虑在 (1) 题目条件基础上,球壳不接地的电势

$$U = U_1 + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

4 静电能

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i U_i$$

注意点电荷、导体、电容运用公式的区别

4.1 能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot \mathbf{E} = w_0 + w'$$

静电能、宏观静电能、介质极化能

4.2 利用静电能求静电力

虚功原理，功能关系

电荷 Q 不变

$$\mathbf{F} = -(\nabla W_e)_Q$$

电势差 U 不变

$$\mathbf{F} = (\nabla W_e)_U$$

注意：电源做功是系统静电能变化的两倍

4.3 习题 3.4

3.4 假定电子是球形的，并且它的静止能量 mc^2 (m 是它的静质量， c 是真空光速) 就是来自它的静电能量。这样就可以由它的电荷分布算出它的半径。

(1) 假定电子电荷 e 均匀分布在球面上，求电子的半径；

(2) 假定电子电荷 e 均匀分布在球体内，求电子的半径；

(3) 由于假定电荷分布情况不同，算出的电子半径便稍有不同。目前把 $r_0 = e^2 / (4\pi\varepsilon_0 mc^2)$ 叫做电子的经典半径。已知电子电荷 $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子的静质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求 r_0 的值。

图 5: 习题 3.4

(1)

$$u = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 a}$$
$$W = \frac{1}{2}eU = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} = mc^2$$
$$a = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 mc^2}$$

(2)

$$E = \frac{er}{4\pi\epsilon_0 a^3} (r < a), E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > a)$$
$$U(r) = \int_r^\infty E dr = \frac{e(3a^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 a^3}$$
$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho U dV = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 a} = mc^2$$
$$a = \frac{3e^2}{20\pi\epsilon_0 mc^2}$$

5 其它

5.1 习题 2.5

2.5 如习题 2.5 图所示, 在金属球 A 内有两个球形空腔, 此金属球整体上不带电, 在两空腔中心各放置一点电荷 q_1 和 q_2 , 在金属球 A 之外远处放置一点电荷 q (q 至 A 中心距离 $r \gg$ 球 A 的半径 R), 计算作用在 A 、 q_1 、 q_2 、 q 四物体上的静电力.

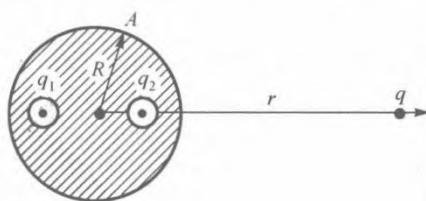


图 6: 习题 2.5

$$\mathbf{F}_{q1} = \mathbf{F}_{q2} = 0$$
$$\mathbf{F}_q = -\mathbf{F}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(q_1 + q_2)q}{r^2} \hat{r}$$

5.2 补充题

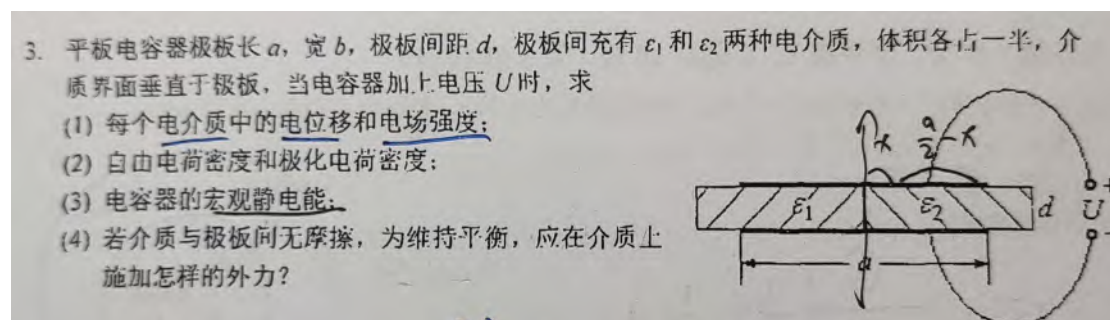


图 7: 某年期中题

更正习题课上讲的有问题的地方：

(1)

直接用电容关系算，不需要列高斯定理（更简单了）

$$E = \frac{U}{d}$$

$$D_i = \epsilon_i E$$

(3)

题目求的是宏观静电能，利用 4.1 能量密度公式求

$$W_0 = \iiint_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$$